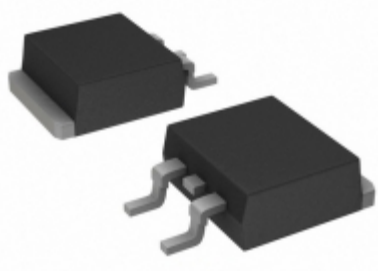

	<h2 style="color: red;">FQB19N20LTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQB19N20LTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB19N20LTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 49405 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQB19N20LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	49405 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 21A (Tc) 3.13W (Ta), 140W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB19N20LTM-ND

FQB19N20LTM ist neu im Original, Suche FQB19N20LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB19N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB19N20LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB19N20LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK</p>	 <p><b>FQB1N60TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK</p>
 <p><b>FQB1N60</b> FAIRCHILD FQB1N60 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB19N20CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N20C</b> F FQB19N20C F</p>	 <p><b>FQB1N60TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQB13N06L	↔ FQB13N10	⇒ FQB13N10L	D FQB13N50	↔ FQB13N50CTM
↔ FQB13N50CTM	⊛ FQB140N03L	D FQB14N30TM	⇒ FQB14N30TM	↔ FQB16N25TM
⊛ FQB16N25TM	↔ FQB17P06	⊛ FQB17P10	↔ FQB17P10TM	↔ FQB17P10TM
D FQB19N10L	⊛ FQB19N10LTM	↔ FQB19N10LTM	⊛ FQB19N10TM	↔ FQB19N10TM
⇒ FQB19N20	↔ FQB19N20C	⊛ FQB19N20CTM	↔ FQB19N20CTM	↔ FQB19N20L
↔ FQB19N20LTM	⇒ FQB19N20TM	D FQB19N20TM	⊛ FQB1N60TM	↔ FQB1N60TM
⊛ FQB20N06L	D FQB20N60FTM	⇒ FQB20N60TM	↔ FQB22P10	↔ FQB22P10TM
↔ FQB22P10TM	⊛ FQB22P10TM_F085	↔ FQB24N08TM	⇒ FQB24N08TM	↔ FQB25N33
⊛ FQB25N33TM	↔ FQB25N33TM	⊛ FQB25N33TM_F085	D FQB27N25TM	↔ FQB27P06
↔ FQB27P06TM	⊛ FQB27P06TM	↔ FQB2N50C	⊛ FQB2N60TM	↔ FQB2N60TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

